

## 三安光电股份有限公司

### 关于签署《投资合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要提示：

1、本公司于 2017 年 12 月 5 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了关于公司与福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府签署《投资合作协议》的议案。根据协议约定：公司拟在福建省泉州芯谷南安园区投资注册成立一个或若干项目公司，投资总额 333 亿元（含公共配套设施投资，单位：人民币，下同），全部项目五年内实现投产，七年内全部项目实现达产，经营期限不少于 25 年。产业化项目为：1、高端氮化镓 LED 衬底、外延、芯片的研发与制造产业化项目；2、高端砷化镓 LED 外延、芯片的研发与制造产业化项目；3、大功率氮化镓激光器的研发与制造产业化项目；4、光通讯器件的研发与制造产业化项目；5、射频、滤波器的研发与制造产业化项目；6、功率型半导体（电力电子）的研发与制造产业化项目；7、特种衬底材料研发与制造、特种封装产品应用研发与制造产业化项目。

2、本次投资合作协议事项尚待公司股东大会审议批准。公司将根据有关规定，履行内部审议程序及信息披露义务。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、协议主体情况

##### 1、相关协议方

甲方：福建省泉州市人民政府

乙方：福建省南安市人民政府

丙方：三安光电股份有限公司

##### 2、协议签订目的

甲方、乙方为推动泉州芯谷南安园区（以下简称“园区”）尽快形成规模化生产的 III-V 族化合物半导体、集成电路的研发及产业基地，提升 III-V 族化合物

半导体、集成电路产业核心竞争力，欢迎并鼓励本公司在园区投资建设化合物半导体、集成电路及相关产业项目，并对项目在园区的发展给予积极支持。

根据《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》（国办发[2017]79号）关于“发挥财政性资金带动作用，通过投资补助、资本金注入、设立基金等方式，广泛吸纳各类社会资本，支持企业加大技术改造力度，加大对化合物半导体、集成电路等关键领域和薄弱环节重点项目的投入”等文件精神，三方本着优势互补、互利互惠原则，经友好协商，达成本协议。

## 二、协议主要条款

### 1、投资项目及规模

本公司在园区投资注册成立一个或若干项目公司（项目公司名称待定，以下简称“项目公司”），投资总额 333 亿元（含公共配套设施投资），达产后年销售收入约 270 亿元（按当前产品单价计算）。产业化项目：1、高端氮化镓 LED 衬底、外延、芯片的研发与制造产业化项目；2、高端砷化镓 LED 外延、芯片的研发与制造产业化项目；3、大功率氮化镓激光器的研发与制造产业化项目；4、光通讯器件的研发与制造产业化项目；5、射频、滤波器的研发与制造产业化项目；6、功率型半导体（电力电子）的研发与制造产业化项目；7、特种衬底材料研发与制造、特种封装产品应用研发与制造产业化项目。

甲方、乙方应尽快将符合本协议约定条件的项目用地交付给本公司，本公司在项目用地具备开工条件后即实施开工建设。三方应严格履行本协议约定事项，在甲方、乙方同意给予本公司和项目公司的本协议项下各项投资优惠政策和政府支持都能落实到位的情况下，全部项目力争五年内实现投产，七年内全部项目实现达产。本公司承诺项目公司在园区经营不少于 25 年。

### 2、项目用地、基础设施及开工条件

项目用地总面积 2500 亩，性质为工业用地，土地使用权期限为 50 年，选址位于园区内。甲方、乙方承诺，按照国有土地使用权相关法律规定办理出让，由项目公司依法参与招拍挂，并于 2017 年 12 月 31 日前依法取得首批 1000 亩，并于 2018 年 3 月 15 日前依法取得余下项目用地 1500 亩。

甲方、乙方承诺，项目用地的基础设施达到“八通一平”，在本项目开工建设前全部完成。项目公司可自建 11 万伏变电所，甲方、乙方负责变电所外部的

双回路电源架设，并确保变电所可供应本协议项下各项目公司的用电。甲方、乙方同意本公司和项目公司可根据实际情况需要，在项目用地范围内建设特种气体气源、原材料等配套厂。

### 3、投资优惠政策

甲方、乙方在有关规章、政策的指导下同意给予项目公司基础设施及工程建设补助、设备购置补助、纳税贡献奖励、市场开拓和产业发展奖励等一系列优惠措施。

协议还就违约责任、保密责任、争议解决、其他事项等进行了界定。

### 三、协议履行对公司的影响

公司主要从事III-V族化合物半导体材料的研发与应用，着重于砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到的外延、芯片核心主业，努力打造具有国际竞争力的半导体厂商。

本次投资项目属于国家着力打造的新兴战略性新兴产业，具有节能环保等特点；符合公司产业发展方向和发展战略，目的是把主业做大做强做精，可充分发挥公司产业协同效应，丰富公司产品类别，大力提升公司产品附加值，延伸公司产业链，有利于进一步扩大公司产能，巩固公司行业地位，继续提升市场占有率，开拓新的应用领域，打造具有全球影响力的化合物半导体企业。

### 四、协议履行的风险分析

1、《投资合作协议》所涉及的具体投资项目尚未取得公司股东大会的审核批准，投资协议能否按照约定的内容按期执行尚存在不确定性。在协议履行过程中，国家法律法规的变化等存在不确定性。

2、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件：

《投资合作协议》文本。

特此公告。

三安光电股份有限公司

二〇一七年十二月六日